PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-337419

(43)Date of publication of application: 28.11.2003

(51)Int.CI.

G03F 7/039 C08F220/18 C08F220/28 H01L 21/027

(21)Application number: 2003-066164

(71)Applicant:

JSR CORP

(22)Date of filing: 12.03.2003 (72)Inventor: **NISHIMURA YUKIO** ISHII HIROYUKI

YAMAMOTO MASASHI **NISHIMURA ISAO**

(30)Priority

Priority number : 2002071696

Priority date: 15.03.2002

Priority country: JP

(54) RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a radiation-sensitive resin composition having high transparency to a radiation and suitable for use as a chemically amplified resist excellent in basic properties as a resist, such as sensitivity, resolution, dry etching resistance and pattern shape. SOLUTION: The radiation-sensitive resin composition comprises (A) a resin which becomes alkali-soluble by the action of an acid and contains a repeating unit derived from (meth)acrylic esters typified by 1-(2norbornyl)-1-methylethyl (meth)acrylate and 2-ethyl-2-adamantyl (meth) acrylate and a repeating unit derived from (meth)acrylic esters having a lactone skeleton typified by a compound represented by formula (i) or (ii) (where R is H or methyl) and (B) a radiation-sensitive acid generator.

(ii)

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-337419 (P2003-337419A)

(43)公開日 平成15年11月28日(2003.11.28)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)	
G03F 7/039	601	G03F 7/039	601 2H025	
C08F 220/18		C 0 8 F 220/18	4J100	
220/28		220/28		
H01L 21/027		H01L 21/30	5 0 2 R	
		審査請求 未請求 請求	求項の数 6 OL (全 26 頁)	,
(21)出願番号	特顧2003-66164(P2003-66164)	(71)出顧人 000004178		_
(22)出顧日	平成15年3月12日(2003.3.12)		央区築地五丁目 6 番10号	
(4) 医开格子组成日	####0000 71000/D0000 71000)	(72)発明者 西村 幸		
	特度2002-71696 (P2002-71696)		央区築地二丁目11番24号 ジェイ	
(32) 優先日	平成14年3月15日(2002.3.15)		ル株式会社内	
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者 石井 寛志		
			央区築地二丁目11番24号 ジェイ	
		エスアーノ	心株式会社内	
		(74)代理人 100100985	i	
		弁理士 神	福沢 俊明	
		1		

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 放射線に対する透明性が高く、感度、解像 度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジスト としての基本性能に優れた化学増幅型レジストとして好 適な感放射線性樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)(メタ)アクリル酸1-(2-ノルボルニル)-1-メチルエチル、(メタ)アクリル酸2-エチル-2-アダマンチル等で代表される(メタ)アクリル酸エステル類に由来する繰り返し単位と、下記式(i)または式(ii)で表される化合物等で代表されるラクトン骨格を有する(メタ)アクリル酸エステル類に由来する繰り返し単位とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有する。【化1】

最終頁に続く

(但し、Rは水素原子またはメチル基を示す。)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 下記一般式(1) に示す繰り返し 単位(1-1) および繰り返し単位(1-2)(但し、 繰り返し単位(1-1)に相当する単位を除く。)の群 から選ばれる繰り返し単位の少なくとも1種と、下記一 般式(2)に示す繰り返し単位(2-1)、繰り返し単 位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の群から選米

1

* ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少なくとも 1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに (B) 感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする 感放射線性樹脂組成物。

[12]

〔一般式(1)において、R1は水素原子あるいはメチ ル基を示し、A1 は単結合または-X1 -COO-(但 し、X1 はメチレン基、炭素数10以下の直鎖状もしく は分岐状のアルキレン基または炭素数10以下の非有橋 型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基を示す。) を示し、各R'は相互に独立に炭素数1~6の直鎖状も しくは分岐状のアルキル基を示し、R³は水素原子、炭 素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または 炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機基 を示し、nは0または1であり、R1は水素原子あるい はメチル基を示し、A'は単結合または-X'-COO - (但し、X'はメチレン基、炭素数10以下の直鎖状 もしくは分岐状のアルキレン基または炭素数10以下の※ ※非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基を示 す。)を示し、各R'は相互に独立に炭素数1~4の直 鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20 の非有橋型もしくは有橋型の1価の脂環式炭化水素基を 示し、かつ少なくとも1つのR'が炭素数1~4の直鎖 状もしくは分岐状のアルキル基であるか、あるいは何れ か2つのR'が相互に結合して、それぞれが結合してい る炭素原子と共に炭素数4~20の非有橋型もしくは有 橋型の2価の脂環式炭化水素基を形成し、残りのR'が 炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示 す。) (化2)

〔一般式(2) において、R° は水素原子あるいはメチ ル基を示し、 A^3 は単結合または $-X^3-COO-(但 50$ は分岐状のアルキレン基または炭素数10以下の非有橋

し、X³ はメチレン基、炭素数10以下の直鎖状もしく

(3)

4

型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基を示す。)を示し、R'は炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機基を示し、複数存在するR'は相互に同一でも異なってもよく、iは0~4の整数であり、jは0または1であり、kは1~3の整数であり、R°は水素原子あるいはメチル基を示し、Bはメチレン基、酸素原子または硫黄原子を示し、R°は水素原子、炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有機基を示す。〕

【請求項2】 (A1)請求項1に記載の繰り返し単位 (1-1)と、請求項1に記載の繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性 20の樹脂、(A2)請求項1に記載の繰り返し単位(1-2)(但し、繰り返し単位(1-1)に相当する単位を除く。)と、請求項1に記載の繰り返し単位(2-**

*1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物。

【請求項3】 繰り返し単位(1-2)中の-C(R⁵), 構造が2-メチル-2-トリシクロデカニル基、2-エチル-2-トリシクロデカニル基、2-メチル-2-アダマンチル基、2-エチル-2-アダマンチル基、1-メチルシクロペンチル基、1-メチルシクロペキシル基または1-エチルシクロペキシル基であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の感放射線性樹脂組成物。

【請求項4】 繰り返し単位(2-1)が下記式(2-1-1)、式(2-1-2)、式(2-1-3)または式(2-1-4)で表される繰り返し単位からなり、繰り返し単位(2-2)が下記式(2-2-1)で表される繰り返し単位からなり、繰り返し単位(2-3)が下記式(2-3-1)で表される繰り返し単位からなることを特徴とする請求項 $1\sim3$ の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

【化3】

〔但し、R°は一般式(2−1)におけるR°と同義である。〕 【化4】

〔但し、R°は一般式(2-2)におけるR°と同義であり、R¹°は一般式(2-3)におけるR¹°と同義である。〕

【請求項5】 (A)成分の樹脂におけるラクトン骨格を有する繰り返し単位、あるいは(A1)成分の樹脂および/または(A2)成分の樹脂中におけるラクトン骨格を有する繰り返し単位が、請求項4に記載の式(2-1-1)で表される繰り返し単位からなることを特徴と40 する請求項4に記載の感放射線性樹脂組成物。

【請求項6】 (A)成分の樹脂、あるいは(A1)成分の樹脂および/または(A2)成分の樹脂が、さらに下記一般式(3)で表される繰り返し単位を含有することを特徴とする請求項1~5の何れかに記載の感放射線性樹脂組成物。

【化5】

$$\begin{array}{c}
R^{12} \\
- C \\
C \\
C \\
C \\
C
\end{array}$$
(3)

[一般式(3) において、R¹¹は水素原子あるいはメチル基を示し、Yはフッ素原子で置換されてもよい炭素数 10 12以下のm価の炭化水素基を示し、Dは(m − 1)価の極性基を示し、mは2または3である。〕

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、KrFエキシマレーザー、ArFエキシマレーザー、F,エキシマレーザー等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き各種の放射線を使用する微細加工に有用な化学増幅型レジストとして好適に使用するととができる感放射線性樹脂組成物に関わる。

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加

工の分野においては、より高い集積度を得るために、最

近では0.20μm以下のレベルでの微細加工が可能な

[0002]

リソグラフィー技術が必要とされている。従来のリソグ ラフィープロセスでは、一般に放射線として i 線等の近 紫外線が用いられているが、この近紫外線では、サブク オーターミクロンレベルの微細加工が極めて困難である と言われている。そこで、0.20 µm以下のレベルで の微細加工を可能とするために、より波長の短い放射線 30 の利用が検討されている。このような短波長の放射線と しては、例えば、水銀灯の輝線スペクトル、エキシマレ ーザーに代表される遠紫外線、X線、電子線等を挙げる ことができるが、これらのうち、特にKrFエキシマレ ーザー(波長248nm)あるいはArFエキシマレー ザー(波長193nm)が注目されている。このような エキシマレーザーによる照射に適したレジストとして、 酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射(以下、 「露光」という。)により酸を発生する成分(以下、 「感放射線性酸発生剤」という。)とによる化学増幅効 果を利用したレジスト(以下、「化学増幅型レジスト」 という。)が数多く提案されている。化学増幅型レジス トとしては、例えば、特公平2-27660号公報に は、カルボン酸のt-ブチルエステル基またはフェノー ルのt-ブチルカーボナート基を有する重合体と感放射 線性酸発生剤とを含有するレジストが提案されている。 このレジストは、露光により発生した酸の作用により、 重合体中に存在する t ーブチルエステル基あるいは t ー

ブチルカーボナート基が解離して、該重合体がカルボキ

シル基あるいはフェノール性水酸基からなる酸性基を有

するようになり、その結果、レジスト被膜の露光領域が アルカリ現像液に易溶性となる現象を利用したものであ る。

6

【0003】ところで、従来の化学増幅型レジストの多 くは、フェノール系樹脂をベースにするものであるが、 このような樹脂の場合、放射線として遠紫外線を使用す ると、樹脂中の芳香族環に起因して遠紫外線が吸収され るため、露光された遠紫外線がレジスト被膜の下層部ま で十分に到達できないという欠点があり、そのため露光 量がレジスト被膜の上層部では多く、下層部では少なく なり、現像後のレジストパターンが上部が細く下部にい くほど太い台形状になってしまい、十分な解像度が得ら れないなどの問題があった。その上、現像後のレジスト バターンが台形状となった場合、次の工程、即ちエッチ ングやイオンの打ち込みなどを行う際に、所望の寸法精 度が達成できず、問題となっていた。しかも、レジスト パターン上部の形状が矩形でないと、ドライエッチング によるレジストの消失速度が速くなってしまい、エッチ ング条件の制御が困難になる問題もあった。一方、レジ 20 ストパターンの形状は、レジスト被膜の放射線透過率を 高めることにより改善することができる。例えば、ポリ メチルメタクリレートに代表される(メタ)アクリレー ト系樹脂は、遠紫外線に対しても透明性が高く、放射線 透過率の観点から非常に好ましい樹脂であり、例えば特 開平4-226461号公報には、メタクリレート系樹 脂を使用した化学増幅型レジストが提案されている。し かしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れ ているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチ ング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度の エッチング加工を行うことが困難であり、放射線に対す る透明性とドライエッチング耐性とを兼ね備えたものと は言えない。

【0004】また、化学増幅型レジストについて、放射 線に対する透明性を損なわないで、ドライエッチング耐 性を改善する方策の一つとして、レジスト中の樹脂成分 に、芳香族環に代えて脂肪族環を導入する方法が知られ ており、例えば特開平7-234511号公報には、脂 肪族環を有する(メタ)アクリレート系樹脂を使用した 化学増幅型レジストが提案されている。しかしながら、 このレジストでは、樹脂成分が有する酸解離性官能基と して、従来の酸により比較的解離し易い基(例えば、テ トラヒドロピラニル基等のアセタール系官能基)や酸に より比較的解離し難い基(例えば、t-ブチルエステル 基、t-ブチルカーボネート基等のt-ブチル系官能 基)が用いられており、前者の酸解離性官能基を有する 樹脂成分の場合、レジストの基本物性、特に感度やパタ ーン形状は良好であるが、組成物としての保存安定性に 難点があり、また後者の酸解離性官能基を有する樹脂成 分では、逆に保存安定性は良好であるが、レジストの基 50 本物性、特に感度やパターン形状が損なわれるという欠 点がある。さらに、このレジスト中の樹脂成分には脂肪族環が導入されているため、樹脂自体の疎水性が非常に高くなり、基板に対する接着性の面でも問題があった。このような状況の下、集積回路素子における微細化の進行に対応しうる技術開発の観点から、遠紫外線に代表される短波長の放射線に適応可能で、放射線に対する透明性が高く、かつ感度、解像度、ドライエッチング耐性、バターン形状等のレジストとしての基本物性に優れた化学増幅型レジストが強く求められている。

7

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、放射線に対する透明性が高く、感度、解像度、ドライエッチング耐性、パターン形状等のレジストとしての基本性能に優れた化学増幅型レジストとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組成物を提供することにある。*

* [0096]

(5)

10

【課題を解決するための手段】本発明によると、前記課題は、第一に、(A)下記一般式(1)に示す繰り返し単位(1-1)におよび繰り返し単位(1-2)(但し、繰り返し単位(1-1)に相当する単位を除く。)の群から選ばれる繰り返し単位の少なくとも1種と、下記一般式(2)に示す繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに(B)感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする感放射線性樹脂組成物によって達成される。

[0007]

[化6]

【0008】 (-mtx)(1) において、 R^1 は水素原子あるいはメチル基を示し、 A^1 は単結合または $-X^1$ - COO-(但し、 X^1 はメチレン基、炭素数 1 0以下の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基または炭素数 1 0以下の非有橋型もしくは有橋型の 2 価の脂環式炭化水素基を示す。)を示し、各 R^1 は相互に独立に炭素数 1 ~ 6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、 R^1 は水素原子、炭素数 1 ~ 6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数 1 ~ 6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機基を示し、1 は 1 なまたは 1 であり、

【0009】R⁴ は水素原子あるいはメチル基を示し、A² は単結合または-X² -COO-(但し、X² はメチレン基、炭素数10以下の直鎖状もしくは分岐状のア

ルキレン基または炭素数10以下の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基を示す。)を示し、各R は相互に独立に炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基または炭素数4~20の非有橋型もしくは有橋型の1価の脂環式炭化水素基を示し、かつ少なくとも1つのR が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基であるか、あるいは何れか2つのR が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に炭素数4~20の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基を形成し、残りのR が炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示す。〕

[0010]

【化7】

9

$$R^{0}$$
 CH_{2}
 CH_{2}

【0011】 (一般式 (2) において、R⁶ は水素原子 あるいはメチル基を示し、A³ は単結合または-X³ -COO-(但し、X'はメチレン基、炭素数10以下の 直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基または炭素数10 以下の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素 基を示す。)を示し、R'は炭素数1~6の直鎖状もし くは分岐状のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状も しくは分岐状の酸素含有有機基を示し、複数存在するR 'は相互に同一でも異なってもよく、iは0~4の整数 20 であり、jは0または1であり、kは1~3の整数であ り、

【0012】R®は水素原子あるいはメチル基を示し、 Bはメチレン基、酸素原子または硫黄原子を示し、R⁹ は水素原子、炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のア ルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の 酸素含有有機基を示し、

【0013】R¹⁰は水素原子あるいはメチル基を示し、 R11は水素原子、炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状 のアルキル基または炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐 30 状の酸素含有有機基を示す。〕

【0014】本発明によると、前記課題は、第二に、 (A1) 前記繰り返し単位(1-1)と、前記繰り返し 単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返 し単位(2-3)の群から選ばれるラクトン骨格を有す る繰り返し単位の少なくとも1種とを含有し、酸の作用 によりアルカリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアル カリ難溶性の樹脂、(A2)前記繰り返し単位(1-2) (但し、繰り返し単位(1-1) に相当する単位を 除く。) と、前記繰り返し単位(2-1)、繰り返し単 40 位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の群から選 ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少なくとも 1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる アルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂、並びに

(B) 感放射線性酸発生剤を含有することを特徴とする 感放射線性樹脂組成物によって達成される。

【0015】以下、本発明について詳細に説明する。 (A)成分

本発明における(A)成分は、繰り返し単位(1-1) および繰り返し単位(1-2)(但し、繰り返し単位

(1-1)に相当する単位を除く。)の群から選ばれる 繰り返し単位の少なくとも1種と、繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2 -3)の群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し 単位の少なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアル カリ可溶性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性 の樹脂(以下、「樹脂(A)」という。)からなる。以 下では、繰り返し単位(1-2)(但し、繰り返し単位 (1-1) に相当する単位を除く。) を単に「繰り返し 単位(1-2)」という。

【0016】また、本発明における(A1)成分は、繰 り返し単位(1-1)と、繰り返し単位(2-1)、繰 り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の 群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少 なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶 性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂 (以下、「樹脂(A1)」という。) からなる。

【0017】また、本発明における(A2)成分は、繰 り返し単位(1-2)と、繰り返し単位(2-1)、繰 り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の 群から選ばれるラクトン骨格を有する繰り返し単位の少 なくとも1種とを含有し、酸の作用によりアルカリ可溶 性となるアルカリ不溶性またはアルカリ難溶性の樹脂 (以下、「樹脂(A2)」という。) からなる。

【0018】本発明でいう「アルカリ不溶性またはアル カリ難溶性」とは、樹脂(A)を含有する感放射線性樹 脂組成物あるいは樹脂(A1)と樹脂(A2)との混合 物を含有する感放射線性樹脂組成物から形成されたレジ スト被膜からレジストパターンを形成する際に採用され るアルカリ現像条件下で、当該レジスト被膜の代わり に、樹脂(A)あるいは前記混合物のみを用いた被膜を 現像した場合に、当該被膜の初期膜厚の50%以上が現 像後に残存する性質を意味する。

【0019】繰り返し単位(1-1)中のA¹の-X¹ -COO-において、X1 の炭素数10以下の直鎖状も しくは分岐状のアルキレン基としては、例えば、エチレ ン基、プロピレン基、トリメチレン基、テトラメチレン 基、ペンタメチレン基、ヘキサメチレン基、オクタメチ 50 レン基、デカメチレン基等を挙げることができる。

【0020】また、X¹の炭素数10以下の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘブタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類に由来する基;ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタン等の多環型脂環式炭化水素に由来する基;これらの基を、例えば、メチル基、エチル基、ロープロビル基、iープロビル基、nーブチル基、2-メチルプロビル基、iープロビル基、nーブチル基、2-メチルプロビル基、1-メチルプロビル基、tーブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または 10環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。

【0021】繰り返し単位(1-1)において、R² およびR³ の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、n-ペキシル基等を挙げることができる。

【0022】また、R³の炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機基としては、例えば、アルコキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒドロキシアルキル基、アルコキシアルコキシル基等を挙げることができる。

【0023】前記アルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、1-プロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基等を挙げるととができる。

【 0 0 2 4 】前記アルコキシルカルボニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n - プロポキシカルボニル基、i - プロポキシカルボニル基、n - プトキシカルボニル基、2 - メチルプロポキシカルボニル基、1 - メチルプロポキシカルボニル基、t - ブトキシカルボニル基、n - ペンチルオキシカルボニル基、ネオペンチルオキシカルボニル基、n - ヘキシルオキシカルボニル基等を挙げることができる。

【0025】前記ヒドロキシアルキル基としては、例えば、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、3-ヒドロキシ-n-プロピル基、4-ヒドロキシ-n-ブチル基、5-ヒドロキシ-n-ペンチル基、6-ヒドロキシ-n-ヘキシル基等を挙げることができる。

【0026】前記アルコキシアルコキシル基としては、例えば、メトキシメトキシ基、エトキシメトキシ基、2-メトキシエトキシ基、3-メトキシ-n-プロポキシ基、4-メトキシ-n-ブトキシ基、5-メトキシ-n-ペンチルオキシ基等を挙げることができる。

12

【0027】繰り返し単位(1-1)において、 R^1 としては水素原子およびメチル基がともに好ましく、 A^1 としては単結合、 X^1 がノルボルナンまたはアダマンタンに由来する基である $-X^1$ -COO - 等が好ましく、 R^1 としてはメチル基、エチル基等が好ましく、 R^1 としては水素原子、メチル基、エチル基、メトキシ基、エトキシカルボニル基等が好ましく、 R^1 ともに好ましい。樹脂(A)および樹脂(A1)において、繰り返し単位(1-1)は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

【0028】繰り返し単位(1-2)中のA'の-X'-COO-において、X'の炭素数10以下の直鎖状もしくは分岐状のアルキレン基および炭素数10以下の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、前記繰り返し単位(1-1)中のX'について例示したそれぞれ対応する基を挙げることができる

【0029】繰り返し単位(1-2)において、R'の 炭素数1~4の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基とし ては、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 i-プロピル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル 基、1-メチルプロピル基、t-ブチル基等を挙げるこ とができる。

【0030】また、R'の炭素数4~20の非有橋型も

しくは有橋型の1価の脂環式炭化水素基および何れか2つのR⁵が相互に結合して、それぞれが結合している炭素原子と共に形成した炭素数4~20の非有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基としては、例えば、30シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロペブタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類に由来する基;ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタン等の多環型脂環式炭化水素に由来する基;これらの基を、例えば、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、i-ブロビル基、n-ブチル基、2-メチルプロビル基、i-ブロビル基、n-ブチル基、2-メチルプロビル基、1-メチルプロビル基、t-ブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した基等を挙げることができる。

10 【0031】繰り返し単位(1-2)における-C(R'), で表される基の具体例としては、t-ブトキシカルボニル基や、下記式(4-1)~式(4-13)で表される基等を挙げることができる。

[0032]

【化8】

$$H_3C-C-CH_3$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5

[0033] [化9]

[0034]

【化10】

[0035]

【化11】

(4-8)(4-9)

[0036]

【化12】

$$CH_3$$
 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5 C_2H_5

【0037】繰り返し単位(1-2)において、R' と

しては、水素原子およびメチル基がともに好ましく、A ² としては単結合、X² がノルボルナンまたはアダマン タンに由来する基である-X'-COO-等が好まし く、-C(R⁵)。で表される基としては2-メチル-2 - トリシクロデカニル基(式(4-4)参照)、2-エチ ル-2-トリシクロデカニル基(式(4-5)参照)、2 - メチル - 2 - アダマンチル基(式(4-8)参照)、2 - エチル - 2 - アダマンチル基(式(4-9)参照)、1 - メチルシクロペンチル基(式(4-10)参照)、1-エ 10 チルシクロペンチル基(式(4-11)参照)、1-メチル シクロヘキシル基(式(4-12)参照)、1-エチルシク ロヘキシル基(式(4-13)参照)等が好ましい。樹脂 (A) および樹脂 (A2) において、繰り返し単位 (1 -2)は、単独でまたは2種以上が存在することができ る。

【0038】繰り返し単位(2-1)中のA'の-X' -COO-において、X3 の炭素数10以下の直鎖状も しくは分岐状のアルキレン基および炭素数10以下の非 有橋型もしくは有橋型の2価の脂環式炭化水素基として 20 は、例えば、前記繰り返し単位(1-1)中のX¹につ いて例示したそれぞれ対応する基を挙げることができ

【0039】繰り返し単位(2-1)において、R'の 炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基およ び炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機 基としては、前記繰り返し単位(1-1)におけるR' について例示したそれぞれ対応する基を挙げることがで きる。

【0040】繰り返し単位(2-1)において、R°と 30 しては水素原子およびメチル基がともに好ましく、A3 としては単結合、X³ がノルボルナンまたはアダマンタ ンに由来する基である-X3-COO-等が好ましく、 R'としては水素原子、メチル基、エチル基等が好まし く、iとしては0または1が好ましく、jとしては0お よび1がともに好ましく、kとしては1または2が好ま しい。

【0041】好ましい繰り返し単位(2-1)の具体例 としては、下記式(2-1-1)、式(2-1-2)、式(2-1 -3) または式(2-1-4) で表される繰り返し単位を挙げ 40 るととができる。

[0042]

【化13】

(2-1-2)

(2-1-3)

〔但し、R°は一般式(2-1)におけるR°と同義で ある。〕

(2-1-1)

【0043】樹脂(A)、樹脂(A1) および樹脂(A 2) において、繰り返し単位(2-1)は、単独でまた は2種以上が存在することができる。樹脂(A1)およ び樹脂(A2) がともに繰り返し単位(2-1) を含有 ずるとき、樹脂(A 1)における繰り返し単位(2 -1) と樹脂(A2) における繰り返し単位(2-1) と は相互に同一でも異なってもよい。

【0044】繰り返し単位(2-2)において、R°の 炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基およ び炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機 基としては、前記繰り返し単位(1-1)におけるR³ について例示したそれぞれ対応する基を挙げることがで きる。

【0045】繰り返し単位(2-2)において、R°と しては水素原子およびメチル基がともに好ましく、Bと してはメチレン基、酸素原子等が好ましく、R°として は水素原子、メチル基、メトキシ基、メトキシカルボニ 30 ル基等が好ましい。

【0046】繰り返し単位(2-3)において、R11の 炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基およ び炭素数1~6の直鎖状もしくは分岐状の酸素含有有機 基としては、前記繰り返し単位(1-1)におけるR³ について例示したそれぞれ対応する基を挙げることがで きる。

【0047】繰り返し単位(2-3)において、R10と しては水素原子およびメチル基がともに好ましく、R11 としては水素原子が好ましい。

【0048】好ましい繰り返し単位(2-2)の具体例 としては、下記式(2-2-1)で表される単位を挙げると とができ、また好ましい繰り返し単位(2-3)の具体 例としては、下記式(2-3-1)で表される繰り返し単位 を挙げることができる。

[0049]

【化14】

(2-1-4)

〔但し、R°は一般式(2-2)におけるR°と同義で あり、R¹ は一般式(2-3)におけるR¹ と同義であ る。)

【0050】樹脂(A)、樹脂(A1)および樹脂(A 2) において、繰り返し単位(2-2) および繰り返し 単位(2-3)はそれぞれ、単独でまたは2種以上が存 在することができる。樹脂(A1)および樹脂(A2) がともに繰り返し単位(2-2)を含有するとき、樹脂 (A1) における繰り返し単位(2-2) と樹脂(A 2) における繰り返し単位(2-2) とは相互に同一で も異なってもよく、また樹脂(A1)および樹脂(A 2) がともに繰り返し単位(2-3)を含有するとき、 樹脂(A1)における繰り返し単位(2-3)と樹脂 (A2) における繰り返し単位(2-3) とは相互に同 一でも異なってもよい。

【0051】本発明において、樹脂(A)、樹脂(A 1) および樹脂(A2) におけるラクトン骨格を有する 繰り返し単位としては、前記式(2-1-1)、式(2-1-40 2) 、式(2-2-1) または式(2-3-1) で表される繰り 返し単位が好ましく、特に式(2-1-1)で表される繰り 返し単位が好ましい。

【0052】樹脂(A)、樹脂(A1)および樹脂(A 2)は、前記以外の繰り返し単位(以下、「他の繰り返 し単位」という。)を有することもできる。好ましい他 の繰り返し単位としては、例えば、下記一般式(3)で 表される繰り返し単位(以下、「繰り返し単位(3)」 という。)を挙げることができる。

[0053]

【化15】

[一般式(3) において、R¹¹は水素原子あるいはメチル基を示し、Yはフッ素原子で置換されてもよい炭素数 10 12以下のm価の炭化水素基を示し、Dは(m-1)価の極性基を示し、mは2または3である。]

【0054】一般式(3)において、Yの炭素数12以下のm価の炭化水素基としては、例えば、直鎖状もしくは分岐状のアルカン類に由来する基、非有橋型もしくは有橋型の脂環式炭化水素類に由来する基等を挙げることができる。

【 0 0 5 5 】前記アルカン類としては、例えば、メタン、エタン、プロパン、n - ブタン、i - ブタン、n - ペンタン、i - ペンタン、n - ペキサン、n - ペプタン、n - オクタン、n - ノナン、n - デカン、n - ウンデカン、n - ドデカン等を挙げることができる。

【0056】また、前記非有橋型もしくは有橋型の脂環式炭化水素類としては、例えば、シクロブタン、シクロペンタン、シクロペンタン、シクロペキサン、シクロペプタン、シクロオクタン等のシクロアルカン類;ノルボルナン、トリシクロデカン、テトラシクロドデカン、アダマンタン等の多環型脂環式炭化水素類;これらのシクロアルカン類あるいは多環型脂環式炭化水素類を、例えば、メチル基、エ 30チル基、n - プロビル基、i - プロビル基、n - ブチル基、2 - メチルプロビル基、1 - メチルプロビル基、t - ブチル基等の炭素数1~4の直鎖状、分岐状または環状のアルキル基の1種以上あるいは1個以上で置換した化合物等を挙げることができる。

【0057】また、Yのフッ素原子で置換された炭素数 12以下のm価の炭化水素基としては、アルカン類または非有橋型もしくは有橋型の脂環式炭化水素類に由来する基を1個以上のフッ素原子で置換した基を挙げることができ、中でもジ(トリフルオロメチル)メチレン構造 40を有する基が好ましい。

【0058】一般式(3)におけるYとしては、非有橋型もしくは有橋型の脂環式炭化水素類に由来する基が好ましく、さらに好ましくはシクロヘキサン、ノルボルナン、トリシクロデカン、アダマンタンや、これらをメチル基で置換した化合物等に由来する基である。

【0059】一般式(3) において、Dの(m-1) 価 ル基、5-[2-ヒドロキシ-2, 2-ジ(ト! の極性基としては、例えば、ヒドロキシル基、オキソ基 ロメチル)エチル〕<math>-2-ノルボルニル基、8-(即ち、=0)、シアノ基等を挙げることができる。一 ヒドロキシー2、2-ジ(ト!)フルオロメチル) 般式(3) における Yがシクロアルカン類やそのフッ素 50 ル〕-3-トリシクロデカニル基等が好ましい。

化物、あるいは多環型脂環式炭化水素類をアルキル基で 置換した化合物やそのフッ素化物に由来する基である場 合、Dはこれらの基中の環構造に直接結合しても、また 該アルキル基に結合してもよい。一般式(3)における Dとしては、ヒドロキシル基およびシアノ基が好まし い。

【0060】一般式(3)における-Y-D構造としては、例えば、ヒドロキシメチル基、1-ヒドロキシエチル基、2-ヒドロキシエチル基、1-ヒドロキシーn-プロピル基、3-ヒドロキシーn-プロピル基、3-ヒドロキシーn-ブチル基、3-ヒドロキシーn-ブチル基、3-ヒドロキシーn-ブチル基、4-ヒドロキシーn-ブチル基、3-ヒドロキシシクロペンチル基、4-ヒドロキシシクロペンチル基、4-ヒドロキシシクロペンチル基、4-ヒドロキシシクロペンチル基、4-ヒドロキシンクロペンチル基、3-ヒドロキシー3-トリシクロデカニル基、8-ヒドロキシー3-テトラシクロドデカニル基、3-ヒドロキシー1-アダマンチル基、

【0061】3-オキソシクロペンチル基、4-オキソ20 シクロヘキシル基、5-オキソ-2-ノルボルニル基、8-オキソ-3-トリシクロデカニル基、8-オキソ-3-テトラシクロドデカニル基、4-オキソ-1-アダマンチル基、シアノメチル基、2-シアノエチル基、3-シアノ-n-ブラル基、4-シアノ-n-ブチル基、3-シアノシクロペンチル基、4-シアノシクロヘキシル基、5-シアノ-2-ノルボルニル基、8-シアノ-3-トリシクロデカニル基、8-シアノ-3-テトラシクロドデカニル基、3-シアノ-1-アダマンチル基、

【0062】2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル基、3-ヒドロキシ-3、3-ジ(トリフルオロメチル)-n-プロピル基、4-ヒドロキシ-4、4-ジ(トリフルオロメチル)-n-ブチル基、5-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル]-3-トリシクロデカニル基、8-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル]-3-テトラシクロドデカニル基、3-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル]-3-テトラシクロドデカニル基、3-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル]-1-アダマンチル基等を挙げることができる。

【0063】 これらの-Y-D構造のうち、5-ヒドロキシ-2-ノルボルニル基、8-ヒドロキシ-3-トリシクロデカニル基、3-ヒドロキシ-1-アダマンチル基、5-シアノ-2-ノルボルニル基、8-シアノ-3-トリシクロデカニル基、3-シアノ-1-アダマンチル基、5-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル〕-2-ノルボルニル基、8-〔2-ヒドロキシ-2、2-ジ(トリフルオロメチル)エチル〕-3-トリシクロデカニル其等が好ましい

【0064】さらに、繰り返し単位(3)以外の他の繰 り返し単位を与える重合性不飽和単量体としては、例え ば、(メタ)アクリル酸ノルボルニル、(メタ)アクリ ル酸イソボルニル、(メタ)アクリル酸トリシクロデカ ニル、(メタ)アクリル酸テトラシクロデカニル、(メ タ) アクリル酸ジシクロペンテニル、(メタ) アクリル 酸1-アダマンチル、(メタ)アクリル酸1-アダマン チルメチル等の有橋型炭化水素骨格を有する (メタ) ア クリル酸エステル類; (メタ) アクリル酸メチル、(メ タ) アクリル酸エチル、(メタ) アクリル酸 n - プロピ 10 ル、(メタ) アクリル酸n - ブチル、(メタ) アクリル 酸2-メチルプロピル、(メタ) アクリル酸1-メチル プロピル、(メタ) アクリル酸 t - ブチル、(メタ) ア クリル酸シクロプロピル、(メタ) アクリル酸シクロペ ンチル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル等の有橋型 炭化水素骨格をもたない(メタ)アクリル酸エステル 類:

[0065] α -ヒドロキシメチルアクリル酸メチル、 α -ヒドロキシメチルアクリル酸エチル、 α -ヒドロキ シメチルアクリル酸n-プロピル、α-ヒドロキシメチ 20 ルアクリル酸n-ブチル等のα-ヒドロキシメチルアク リル酸エステル類; (メタ) アクリロニトリル、α-ク ロロアクリロニトリル、クロトンニトリル、マレインニ トリル、フマロニトリル、メサコンニトリル、シトラコ ンニトリル、イタコンニトリル等の不飽和ニトリル化合 物: (メタ) アクリルアミド、N, N-ジメチル (メ タ) アクリルアミド、クロトンアミド、マレインアミ ド、フマルアミド、メサコンアミド、シトラコンアミ ド、イタコンアミド等の不飽和アミド化合物; N-(メ タ) アクリロイルモルホリン、N-ビニル-ε-カプロ 30 ラクタム、N-ビニルピロリドン、ビニルピリジン、ビ ニルイミダゾール等の他の含窒素ビニル化合物: (メ タ) アクリル酸、クロトン酸、マレイン酸、無水マレイ ン酸、フマル酸、イタコン酸、無水イタコン酸、シトラ コン酸、無水シトラコン酸、メサコン酸等の不飽和カル ボン酸 (無水物) 類等の単官能性単量体や、

【0066】1,2-アダマンタンジオールジ(メタ) アクリレート、1,3-アダマンタンジオールジ(メタ)アクリレート、1,4-アダマンタンジオールジ (メタ)アクリレート、トリシクロデカニルジメチロー 40 ルジ(メタ)アクリレート等の有橋型炭化水素骨格を有する多官能性単量体;

【0067】メチレングリコールジ(メタ)アクリレート、エチレングリコールジ(メタ)アクリレート、プロピレングリコールジ(メタ)アクリレート、1, 6-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、2, 5-ジメチル-2, 5-ヘキサンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 8-オクタンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 9-ノナンジオールジ(メタ)アクリレート、1, 4-ピス(2-ヒドロキシプロピル)ベンゼンジ

(メタ) アクリレート、1,3-ビス(2-ヒドロキシブロビル) ベンゼンジ(メタ) アクリレート等の有橋型炭化水素骨格をもたない多官能性単量体等の多官能性単量体を挙げることができる。本発明において、他の繰り返し単位は、単独でまたは2種以上が存在することができる。

20

【0068】樹脂(A)において、繰り返し単位(1-1)と繰り返し単位(1-2)との合計含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、10~80モル%、好ましくは20~70モル%、さらに好ましくは20~60モル%であり、繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の合計含有率は、通常、20~80モル%、好ましくは20~60モル%、さらに好ましくは30~60モル%であり、他の繰り返し単位の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは30モル%以下である。また、樹脂(A)における繰り返し単位(1-1)の含有率は、50モル%以下、好ましくは30モル%以下であることが望ましい。

【0069】との場合、繰り返し単位(1-1)と繰り返し単位(1-2)との合計含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向がある。また、繰り返し単位(2-1)~(2-3)の合計含有率が20モル%未満では、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、組成物の溶剤への溶解性が低下する傾向がある。また、繰り返し単位(1-1)の含有率が50モル%を超えると、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向がある。

【0070】樹脂(A1)において、繰り返し単位(1-1)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、10~80モル%、好ましくは20~70モル%、さらに好ましくは20~60モル%であり、繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の合計含有率は、通常、20~80モル%、好ましくは20~60モル%、さらに好ましくは30~60モル%であり、他の繰り返し単位の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは30モル%以下である。

【0071】との場合、繰り返し単位(1-1)の含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向がある。また、繰り返し単位(2-1)~(2-3)の合計含有率が20モル%未満では、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、組成物の溶剤への溶解性が低下する傾向50がある。

【0072】樹脂(A2)において、繰り返し単位(1-2)の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、10~80モル%、好ましくは20~70モル%、さらに好ましくは20~60モル%であり、繰り返し単位(2-1)、繰り返し単位(2-2)および繰り返し単位(2-3)の合計含有率は、通常、20~80モル%、好ましくは20~60モル%、さらに好ましくは30~60モル%であり、他の繰り返し単位の含有率は、全繰り返し単位に対して、通常、50モル%以下、好ましくは30モル%以下である。

【0073】この場合、繰り返し単位(1-2)の含有率が10モル%未満では、レジストとしての解像度が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向がある。また、繰り返し単位(2-1)~(2-3)の合計含有率が20モル%未満では、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下する傾向があり、一方80モル%を超えると、組成物の溶剤への溶解性が低下する傾向がある。

【0074】また、樹脂(A1)と樹脂(A2)との混 20 合物における繰り返し単位(1-1)の含有率は、両樹脂の全繰り返し単位に対して、50モル%以下であることが好ましい。この場合、繰り返し単位(1-1)の含有率が50モル%を超えると、レジストとしての現像性や基板への密着性が低下するおそれがある。

【0075】樹脂(A)、樹脂(A1) および樹脂(A 2) は、例えば、その各繰り返し単位に対応する重合性 不飽和単量体を、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパ ーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物等 のラジカル重合開始剤を使用し、必要に応じて連鎖移動 剤の存在下、適当な溶媒中で重合することにより製造す ることができる。前記重合に使用される溶媒としては、 例えば、nーペンタン、nーヘキサン、nーヘプタン、 n-オクタン、n-ノナン、n-デカン等のアルカン 類;シクロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタ ン、デカリン、ノルボルナン等のシクロアルカン類;ベ ンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン 等の芳香族炭化水素類;クロロブタン類、ブロモヘキサ ン類、ジクロロエタン類、ヘキサメチレンジブロミド、 クロロベンゼン等のハロゲン化炭化水素類:酢酸エチ ル、酢酸n-ブチル、酢酸i-ブチル、プロピオン酸メ チル等の飽和カルボン酸エステル類;2-ブタノン、4 -メチル-2-ペンタノン、2-ヘプタノン等のケトン 類;テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン類、ジエト キシエタン類等のエーエル類等を挙げることができる。 これらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用 することができる。また、前記重合における反応温度 は、通常、40~120℃、好ましくは50~90℃で あり、反応時間は、通常、1~48時間、好ましくは1 ~24時間である。

【0076】樹脂(A)、樹脂(A1)および樹脂(A 2) のゲルバーミエーションクロマトグラフィ (GP) C) によるポリスチレン換算重量平均分子量(以下、 「Mw」という。)は、通常、1,000~100,0 00、好ましくは1,000~50,000、さらに好 ましくは2,000~50,000である。この場合、 樹脂(A)のMwが1,000未満では、レジストとし ての耐熱性が低下する傾向があり、一方100.000 を超えると、レジストとしての現像性が低下する傾向が ある。また、樹脂(A)、樹脂(A1)および樹脂(A 2) のMwとゲルパーミエーションクロマトグラフィ (GPC) によるポリスチレン換算数平均分子量(以 下、「Mn」という。)との比(Mw/Mn)は、通 常、1~5、好ましくは1~3である。なお、樹脂 (A)、樹脂(A1)および樹脂(A2)は、ハロゲ ン、金属等の不純物が少ないほど好ましく、それによ り、レジストとしたときの感度、解像度、プロセス安定 性、パターン形状等をさらに改善することができる。樹 脂(A)の精製法としては、例えば、水洗、液々抽出等 の化学的精製法や、これらの化学的精製法と限外ろ過、 遠心分離等の物理的精製法との組み合わせ等を挙げると とができる。

【0077】(B)成分

本発明における(B)成分は、露光により酸を発生する 感放射線性酸発生剤(以下、「酸発生剤(B)」とい う。)からなる。酸発生剤(B)は、露光により発生し た酸の作用によって、樹脂(A)中に存在する酸解離性 基を解離させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカ リ現像液に易溶性となり、ポジ型のレジストバターンを 形成する作用を有するものである。本発明における酸発 生剤(B)としては、下記一般式(5)で表される化合 物(以下、「酸発生剤(5)」という。)が好ましい。 【0078】

【化16】

【0079】〔一般式(5)において、R¹¹は水素原子、水酸基、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基、炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基、炭素数2~11の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニル基を示し、R¹¹は水素原子または炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基を示し、pは0~3の整数であり、各R¹¹は相互に独立に炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル50基、置換されていてもよいフェニル基または置換基され

(13)

40

ていてもよいナフチル基を示すか、あるいは2つのR"が互いに結合して炭素数2~10の2価の基を形成しており、該2価の基は置換されていてもよく、qは0~2の整数であり、 Z^- は C_*F_{****} SO,の構造を有するアニオンを示し、aは1~10の整数である。〕

23

【0080】一般式(5)において、R¹³、R¹⁴およびR¹⁴の炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、i-ブロビル基、n-ブチル基、2-メチルプロビル基、1-メチルプロビル基、t-ブチル基、n-ベンチル基、ネオペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘブチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、n-ノニル基、n-デシル基等を挙げることができる。

【0081】また、R¹¹の炭素数1~10の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、i-プロポキシ基、n-プトキシ基、2-メチルプロポキシ基、1-メチルプロポキシ基、t-ブトキシ基、n-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-ヘプチルオキシ基、n-オクチルオキシ基、2-エ 20チルヘキシルオキシ基、n-ノニルオキシ基、n-デシルオキシ基等を挙げることができる。

【0082】また、 R^{13} の炭素数 $2\sim11$ の直鎖状もしくは分岐状のアルコキシカルボニル基としては、例えは、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、n つプロポキシカルボニル基、i つプロポキシカルボニル基、i つプロポキシカルボニル基、i つプロポキシカルボニル基、i つプロポキシカルボニル基、i カルボニル基、i つガトキシカルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニル基、i カルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニル 基、i カルボニルオキシ基、i カルボニルオキシ基、i カルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシカルボニルオキシ基等を挙げることができる。

【0083】一般式(5)におけるR¹³としては、水素原子、水酸基、メトキシ基、エトキシ基、n-ブトキシ基等が好ましい。一般式(5)において、R¹⁴としては、水素原子、メチル基等が好ましい。また、pとしては、0または1が好ましい。

フェニル基を、ヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ基等の1個以上あるいは1種以上で置換した基等を挙げることができる。

【0085】フェニル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基のうち、前記アルコキシル基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ロープロポキシ基、iープロポキシ基、ローブトキシ基、2ーメチルプロポキシ基、1ーメチルプロポキシ基、tーブトキシ基、シクロペンチルオキシ基、シクロペキシルオキシ基等の炭素数1~20の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシル基等を挙げることができる。また、前記アルコキシアルキル基としては、例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基、1ーエトキシエチル基、2ーエトキシエチル基等の炭素数2~21の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコキシアルキル基等を挙げることができる。

【0086】また、前記アルコキシカルボニル基として は、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、n-プロポキシカルボニル基、i-プロポキシカ ルボニル基、n - ブトキシカルボニル基、2 - メチルブ ロポキシカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニ ル基、t-ブトキシカルボニル基、シクロペンチルオキ シカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル等の 炭素数2~21の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルコ キシカルボニル基等を挙げることができる。また、前記 アルコキシカルボニルオキシ基としては、例えば、メト キシカルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ シカルボニルオキシ基、n-ブトキシカルボニルオキシ 基、 t - ブトキシカルボニルオキシ基、シクロペンチル オキシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル 等の炭素数2~21の直鎖状、分岐状もしくは環状のア ルコキシカルボニルオキシ基等を挙げることができる。 【0087】また、Rいの置換されていてもよいナフチ ル基としては、例えば、1-ナフチル基、2-メチルー 1-ナフチル基、3-メチル-1-ナフチル基、4-メ チルー1ーナフチル基、4ーメチルー1ーナフチル基、 5-メチル-1-ナフチル基、6-メチル-1-ナフチ ル基、7-メチル-1-ナフチル基、8-メチル-1-ナフチル基、2、3-ジメチル-1-ナフチル基、2、 4-ジメチル-1-ナフチル基、2,5-ジメチル-1 -ナフチル基、2,6-ジメチル-1-ナフチル基、 2, 7-ジメチル-1-ナフチル基、2, 8-ジメチル -1-ナフチル基、3,4-ジメチル-1-ナフチル 基、3、5-ジメチル-1-ナフチル基、3、6-ジメ チルー1ーナフチル基、3,7ージメチルー1ーナフチ ル基、3、8-ジメチル-1-ナフチル基、4、5-ジ

チル基、4-エチル-1-ナフチル基2-ナフチル基、 1-メチル-2-ナフチル基、3-メチル-2-ナフチ ル基、4-メチル-2-ナフチル基等のナフチル基また は炭素数1~10の直鎖状、分岐状もしくは環状のアル キル基で置換されたナフチル基: これらのナフチル基ま たはアルキル置換ナフチル基を、ヒドロキシル基、カル ボキシル基、シアノ基、ニトロ基、アルコキシル基、ア ルコキシアルキル基、アルコキシカルボニル基、アルコ キシカルボニルオキシ基等の1個以上あるいは1種以上 で置換した基等を挙げることができる。

25

【0088】ナフチル基およびアルキル置換ナフチル基 に対する置換基であるアルコキシル基、アルコキシアル キル基、アルコキシカルボニル基およびアルコキシカル ボニルオキシ基としては、例えば、前記フェニル基およ びアルキル置換フェニル基について例示したそれぞれ対 応する基を挙げることができる。また、2つのR11が互 いに結合して形成した炭素数2~10の2価の基として は、式中の硫黄原子と共に5員または6員の環状構造、 特に好ましくは5員の環状構造(即ち、テトラヒドロチ オフェン環構造)を形成する基が望ましい。また、前記 20 2価の基に対する置換基としては、例えば、前記フェニ ル基およびアルキル置換フェニル基に対する置換基とし て例示したヒドロキシル基、カルボキシル基、シアノ 基、ニトロ基、アルコキシル基、アルコキアルキル基、 アルコキシカルボニル基、アルコキシカルボニルオキシ 基と同様のものを挙げることができる。

【0089】一般式(5)におけるR11としては、メチ ル基、エチル基、フェニル基、2つのR15が互いに結合 して硫黄原子と共にテトラヒドロチオフェン環構造を形 成する2価の基等が好ましい。

【0090】一般式(5)において、qとしては、0ま たは1が好ましい。また、Z- のC。F,a,1SO, - 中 基であるが、該パーフルオロアルキル基は直鎖状もしく は分岐状であることができる。 Z- におけるaとしては 4または8が好ましい。

【0091】酸発生剤(5)の具体例としては、トリフ ェニルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、 トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンス ルホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、1-ナフチルジメチルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチ ルジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスル ホネート、1-ナフチルジメチルスルホニウムパーフル オローn-オクタンスルホネート、1-ナフチルジエチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-ナフチルジエチルスルホニウムノナフルオロー n - ブタ ンスルホネート、1-ナフチルジェチルスルホニウムバ ーフルオローn-オクタンスルホネート、

【0092】4-ヒドロキシ-1-ナフチルジメチルス 50 ト、1-(4-n-ブトキシフェニル)テトラヒドロチ

ルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒド ロキシー 1 - ナフチルジメチルスルホニウムノナフルオ ローn-プタンスルホネート、4-ヒドロキシー1-ナ フチルジメチルスルホニウムパーフルオロ**-**n-オクタ ンスルホネート、4-ヒドロキシ-1-ナフチルジエチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-ヒドロキシー1-ナフチルジエチルスルホニウムノナフ ルオロ-n-ブタンスルホネート、4-ヒドロキシ-1 -ナフチルジエチルスルホニウムパーフルオロ-n-オ クタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチルジメチ ルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネート、4-シアノー1ーナフチルジメチルスルホニウムノナフルオ ローn-ブタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチ ルジメチルスルホニウムパーフルオローnーオクタンス ルホネート、

26

【0093】4-シアノ-1-ナフチルジエチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、4~シアノー 1-ナフチルジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-シアノ-1-ナフチルジエチ ルスルホニウムパーフルオロー n - オクタンスルホネー ト、4-ニトロ-1-ナフチルジメチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-ニトロ-1-ナフ チルジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンス ルホネート、4-ニトロ-1-ナフチルジメチルスルホ ニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、4-ニトロー1-ナフチルジエチルスルホニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、4-ニトロ-1-ナフチルジェ チルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネー ト、4-ニトロ-1-ナフチルジエチルスルホニウムパ 30 ーフルオローnーオクタンスルホネート、

【0094】4-メチル-1-ナフチルジメチルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、4~メチル~ 1-ナフチルジメチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、4-メチル-1-ナフチルジメチ ルスルホニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネー ト、4-メチル-1-ナフチルジエチルスルホニウムト リフルオロメタンスルホネート、4-メチル~1-ナフ チルジエチルスルホニウムノナフルオロ-n-ブタンス ルホネート、4-メチル-1-ナフチルジエチルスルホ ニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) テトラ ヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1-(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4-ヒド ロキシフェニル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル オローnーオクタンスルホネート、

【0095】1-(4-n-プトキシフェニル) テトラ ヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー

オフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネート. 1-(4-n-プトキシフェニル)テトラヒドロチオフ ェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1 (4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒド ロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1 (4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒド ロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テト ラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オクタンス ルホネート、1-(4-メトキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート、1-(4-メトキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート、1-(4-メトキシナフタレン-1 ーイル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオローn -オクタンスルホネート、

27

【0096】1-(4-エトキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンス ルホネート、1-(4-エトキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ 20 タンスルホネート、1-(4-エトキシナフタレン-1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n -オクタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフ タレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナ フタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムノナ フルオローnーブタンスルホネート、1-(4-n-ブ トキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニ ウムパーフルオローn-オクタンスルホネート、1-(4-メトキシメトキシナフタレン-1-イル)テトラ 30 フェニウムパーフルオロ-n-オクタンスルホネート、 ヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1 - (4 - メトキシメトキシナフタレン - 1 - イ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー n - ブ タンスルホネート、1-(4-メトキシメトキシナフタ レン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル オローn-オクタンスルホネート、

ト、1-(4-(2-x)++) ナフタレンー 1-(4) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオロメ タンスルホネート、1-(4-(2-x)++) エトキ シ) ナフタレンー1-(4) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロー1-(4-(2-x)++) エトキシ)ナフタレンー1-(4-(2-x)++) エトキシ)ナフタレンー1-(4-(2-x)++) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー1-(4-(2-x)++) フェニウムパーフルオロー1-(4-(2-x)++) ルホネート、

【0098】1-(4-メトキシカルボニルオキシナフ タレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、1-(4-メトキシカルボ ニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフ ェニウムノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、1-(4-メトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-オ クタンスルホネート、1-(4-エトキシカルボニルオ キシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウ ムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-エトキ シカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒド ロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネー ト、1-(4-エトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、1-(4-n-プロポキシ カルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウムトリフルオロメタンスルホネート、1-(4-n-プロポキシカルボニルオキシナフタレン-1 - イル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n -ブタンスルホネート、1-(4-n-プロポキシカル ボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオ 【0099】1-(4-i-プロポキシカルボニルオキ シナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウム トリフルオロメタンスルホネート、1 - (4 - i - プロ ポキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラ ヒドロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホ ネート、1-(4-i-プロポキシカルボニルオキシナ フタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパー フルオローnーオクタンスルホネート、1-(4-n-プトキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル)テト ラヒドロチオフェニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、1-(4-n-ブトキシカルボニルオキシナフタレ ン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオ ローn-ブタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシ カルボニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロ チオフェニウムパーフルオローn-オクタンスルホネー ト、1-(4-t-ブトキシカルボニルオキシナフタレ ンー1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、1-(4-t-ブトキシカルボ ニルオキシナフタレン-1-イル) テトラヒドロチオフ

(4-t-7)トキシカルボニルオキシナフタレン-1-イル)テトラヒドロチオフェニウムパーフルオロ-n-1オクタンスルホネート、

29

【0101】1-〔4-(2-テトラヒドロフラニルオ キシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオフェニ ウムトリフルオロメタンスルホネート、1-[4-(2 20 -テトラヒドロフラニルオキシ) ナフタレン-1-イ ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート、1-[4-(2-テトラヒドロフラ ニルオキシ) ナフタレン-1-イル] テトラヒドロチオ フェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、 1-(4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)ナフタ レン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムトリフル オロメタンスルホネート、1-[4-(2-テトラヒド ロピラニルオキシ)ナフタレン-1-イル]テトラヒド ロチオフェニウムノナフルオローn-ブタンスルホネー ト、1-〔4-(2-テトラヒドロピラニルオキシ)ナ フタレン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパー フルオローn-オクタンスルホネート等を挙げることが できる。

【0102】これらの酸発生剤(5)のうち、特に、ト リフェニルスルホニウムノナフルオローn - ブタンスル ホネート、トリフェニルスルホニウムパーフルオローn -オクタンスルホネート、1-(3,5-ジメチル-4 **-ヒドロキシフェニル)テトラヒドロチオフェニウムノ** ナフルオローn-ブタンスルホネート、1-(3,5-ジメチルー4ーヒドロキシフェニル) テトラヒドロチオ フェニウムパーフルオローnーオクタンスルホネート、 1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テトラヒ ドロチオフェニウムノナフルオローnーブタンスルホネ ート、1-(4-ヒドロキシナフタレン-1-イル)テ トラヒドロチオフェニウムパーフルオローnーオクタン スルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタレン-1 - イル)テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ- n -ブタンスルホネート、1-(4-n-ブトキシナフタ レン-1-イル) テトラヒドロチオフェニウムパーフル 50

オローn - オクタンスルホネート、1 - (2 - ナフタレン - 1

【0103】また、酸発生剤(5)以外の感放射線性酸発生剤(以下、「他の酸発生剤」という。)としては、例えば、オニウム塩化合物、ハロゲン含有化合物、ジアゾケトン化合物、スルホン化合物、スルホン酸化合物等を挙げることができる。これらの他の酸発生剤としては、例えば、下記のものを挙げることができる。

【0104】オニウム塩化合物:オニウム塩化合物とし ては、例えば、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホス ホニウム塩、ジアゾニウム塩、ビリジニウム塩等を挙げ ることができる。オニウム塩化合物の具体例としては、 ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジフェニルヨードニウムノナフルオローn-ブタン スルホネート、ジフェニルヨードニウムパーフルオロー n-オクタンスルホネート、ビス (4-t-ブチルフェ ニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホネート、 ビス(4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムノナフル オローn-ブタンスルホネート、ビス (4-t-ブチル フェニル) ヨードニウムパーフルオローnーオクタンス ルホネート、シクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシ ル・メチルスルホニウムトリフルオロメタンスルホネー ト、ジシクロヘキシル・2-オキソシクロヘキシルスル ホニウムトリフルオロメタンスルホネート、2-オキソ シクロヘキシルジメチルスルホニウムトリフルオロメタ ンスルホネート等を挙げることができる。

【0105】ハロゲン含有化合物:ハロゲン含有化合物 としては、例えば、ハロアルキル基含有炭化水素化合 物、ハロアルキル基含有複素環式化合物等を挙げること ができる。ハロゲン含有化合物の具体例としては、フェ ニルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、4-メトキシフェニルビス (トリクロロメチル) - s - トリ アジン、1-ナフチルビス (トリクロロメチル) -s-トリアジン等の(トリクロロメチル)-s-トリアジン 誘導体や、1,1-ビス(4-クロロフェニル)-2. 2,2-トリクロロエタン等を挙げることができる。ジ アゾケトン化合物:ジアゾケトン化合物としては、例え ば、1、3-ジケト-2-ジアゾ化合物、ジアゾベンゾ キノン化合物、ジアゾナフトキノン化合物等を挙げると とができる。ジアゾケトンの具体例としては、1、2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニルクロリド、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニルクロリド、 2. 3. 4. 4'ーテトラヒドロキシベンゾフェノンの 1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステ ルまたは1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン 酸エステル、1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェ

(17)

32

ニル)エタンの1,2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エステルまたは1,2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル等を挙げることができる。
【0106】スルホン化合物:スルホン化合物としては、例えば、β-ケトスルホン、β-スルホニルスルホンや、これらの化合物のα-ジアゾ化合物等を挙げることができる。スルホン化合物の具体例としては、4-トリスフェナシルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン等を挙げることができる。

スルホン酸化合物:スルホン酸化合物としては、例え ば、アルキルスルホン酸エステル、アルキルスルホン酸 イミド、ハロアルキルスルホン酸エステル、アリールス ルホン酸エステル、イミノスルホネート等を挙げること ができる。スルホン酸化合物の具体例としては、ベンゾ イントシレート、ピロガロールのトリス (トリフルオロ メタンスルホネート)、ニトロベンジル-9,10-ジ エトキシアントラセン-2-スルホネート、トリフルオ ロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5 -エン-2、3-ジカルボキシイミド、ノナフルオロー n-ブタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、パーフルオロ -n-オクタンスルホニルビシクロ[2.2.1]へブ ト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-ヒド ロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホネー ト、N-ヒドロキシスクシンイミドノナフルオロ-n-ブタンスルホネート、N-ヒドロキシスクシンイミドバ ーフルオロ-n-オクタンスルホネート、1,8-ナフ タレンジカルボン酸イミドトリフルオロメタンスルホネ ート、1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドノナフル オローn-ブタンスルホネート、1、8-ナフタレンジ カルボン酸イミドパーフルオローn-オクタンスルホネ ート等を挙げることができる。

【0108】トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.2.1]ヘプト-5-エン-2,3-ジカルボキシ 50

イミド、ノナフルオローnーブタンスルホニルビシクロ [2.2.1] ヘプトー5ーエンー2,3ージカルボキシイミド、パーフルオローnーオクタンスルホニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー5ーエンー2,3ージカルボキシイミド、Nーヒドロキシスクシンイミドトリフルオロメタンスルホネート、Nーヒドロキシスクシンイミドノナフルオローnーブタンスルホネート、Nーヒドロキシスクシンイミドパーフルオローnーオクタンスルホネート、1,8ーナフタレンジカルボン酸イミドトリフ ルオロメタンスルホネート等が好ましい。

【0109】本発明において、酸発生剤(B)は、単独でまたは2種以上を混合して使用することができる。本発明において、酸発生剤(B)の使用量は、レジストとしての感度および現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部あるいは樹脂(A1)と樹脂(A2)との混合物100重量部に対して、通常、0.1~20重量部、好ましくは0.5~10重量部である。この場合、酸発生剤(B)の使用量が0.1重量部未満では、感度および現像性が低下する傾向があり、一方20重量部を超えると、放射線に対する透明性が低下して、矩形のレジストバターンを得られ難くなる傾向がある。【0110】添加剤

本発明の感放射線性樹脂組成物には、必要に応じて、酸 拡散制御剤、酸解離性基を有する脂環族添加剤、界面活 性剤、増感剤等の各種の添加剤を配合することができ る。前記酸拡散制御剤は、露光により酸発生剤(B)か ら生じる酸のレジスト被膜中における拡散現象を制御 し、非露光領域における好ましくない化学反応を抑制す る作用を有する成分である。このような酸拡散制御剤を 配合することにより、得られる感放射線性樹脂組成物の 貯蔵安定性が向上し、またレジストとしての解像度がさ らに向上するとともに、露光から現像処理までの引き置 き時間 (PED) の変動によるレジストバターンの線幅 変化を抑えることができ、プロセス安定性に極めて優れ た組成物が得られる。前記酸拡散制御剤としては、レジ ストバターンの形成工程中の露光や加熱処理により塩基 性が変化しない含窒素有機化合物が好ましい。このよう な含窒素有機化合物としては、例えば、下記一般式 (6)

【0111】 【化17】·

[一般式(6) において、各R¹⁶は相互に独立に水素原子、置換もしくは非置換の直鎖状、分岐状もしくは環状のアルキル基、置換もしくは非置換のアリール基または置換もしくは非置換のアラルキル基を示す。]

【0112】で表される化合物(以下、「含窒素化合物 (イ)」という。)、同一分子内に窒素原子を2個有す る化合物(以下、「含窒素化合物(ロ)」という。)、 窒素原子を3個以上有するポリアミノ化合物や重合体 (以下、これらをまとめて「含窒素化合物(ハ)」とい う。)、アミド基含有化合物、ウレア化合物、含窒素複 素環化合物等を挙げることができる。

33

【0113】含窒素化合物(イ)としては、例えば、n ーヘキシルアミン、nーヘプチルアミン、nーオクチル アミン、n-ノニルアミン、n-デシルアミン、シクロ ヘキシルアミン等のモノ (シクロ) アルキルアミン類; ジーnーブチルアミン、ジーnーペンチルアミン、ジー n-ヘキシルアミン、ジ-n-ヘプチルアミン、ジ-n -オクチルアミン、ジ-n-ノニルアミン、ジ-n-デ シルアミン、シクロヘキシルメチルアミン、ジシクロヘ キシルアミン等のジ(シクロ)アルキルアミン類;トリ エチルアミン、トリーnープロピルアミン、トリーnー ブチルアミン、トリーnーペンチルアミン、トリーnー ヘキシルアミン、トリーnーヘプチルアミン、トリーn ーオクチルアミン、トリーnーノニルアミン、トリーn デシルアミン、シクロヘキシルジメチルアミン、メチ ルジシクロヘキシルアミン、トリシクロヘキシルアミン 等のトリ(シクロ)アルキルアミン類:アニリン、N-メチルアニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチ ルアニリン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリ ン、4-ニトロアニリン、ジフェニルアミン、トリフェ ニルアミン、ナフチルアミン等の芳香族アミン類を挙げ るととができる。

【0114】含窒素化合物(ロ)としては、例えば、エ チレンジアミン、N, N, N', N' - テトラメチルエチ レンジアミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレ ンジアミン、4、4'ージアミノジフェニルメタン、 4, 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4, 4'-ジ アミノベンゾフェノン、4,4'-ジアミノジフェニル アミン、2,2-ビス(4-アミノフェニル)プロパ ン、2-(3-アミノフェニル)-2-(4-アミノフ ェニル)プロパン、2-(4-アミノフェニル)-2-(3-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4-アミ ノフェニル) -2-(4-ヒドロキシフェニル) プロバ ン、1,4-ピス〔1-(4-アミノフェニル)-1-メチルエチル〕ベンゼン、1,3-ビス[1-(4-ア ミノフェニル) -1-メチルエチル] ベンゼン、ビス (2-ジメチルアミノエチル) エーテル、ピス (2-ジ エチルアミノエチル)エーテル等を挙げることができ る。含窒素化合物(ハ)としては、例えば、ポリエチレ ンイミン、ポリアリルアミン、N- (2-ジメチルアミ ノエチル) アクリルアミドの重合体等を挙げることがで きる。

【 0 1 1 5 】前記アミド基含有化合物としては、例えば、N-t- プトキシカルボニルジ-n- オクチルアミン、N-t- プトキシカルボニルジ-n- ノニルアミン、N-t- プトキシカルボニルジ-n- デシルアミ

ン、N-t-ブトキシカルボニルジシクロヘキシルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニル-1-アダマンチルア ミン、N-t-プトキシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミン、N, N-ジ-t-ブトキシカルボ ニルー1-アダマンチルアミン、N, N-ジーt-ブト キシカルボニル-N-メチル-1-アダマンチルアミ ン、N-t-ブトキシカルボニル-4,4'-ジアミノ ジフェニルメタン、N, N' -ジ-t-ブトキシカルボ ニルヘキサメチレンジアミン、N, N, N' N' -テト ラー t - プトキシカルボニルヘキサメチレンジアミン、 N, N' -ジ-t-ブトキシカルボニル-1, 7-ジア ミノヘプタン、N, N' -ジ-t-ブトキシカルボニル -1, 8-ジアミノオクタン、N, N' -ジーt-ブト キシカルボニル-1, 9-ジアミノノナン、N, N'-ジー t - プトキシカルボニル-1, 10 - ジアミノデカ ン、N, N' -ジ-t-ブトキシカルボニル-1, 12 -ジアミノドデカン、N, N' -ジ-t-ブトキシカル ボニル-4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、N-t ープトキシカルボニルベンズイミダゾール、N-t-ブ トキシカルボニル-2-メチルベンズイミダゾール、N t - ブトキシカルボニル-2-フェニルベンズイミダ ゾール等のN-t-ブトキシカルボニル基含有アミノ化 合物のほか、ホルムアミド、N-メチルホルムアミド、 N、N-ジメチルホルムアミド、アセトアミド、N-メ チルアセトアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、プ ロピオンアミド、ベンズアミド、ピロリドン、N-メチ ルピロリドン等を挙げることができる。

【0116】前記ウレア化合物としては、例えば、尿 素、メチルウレア、1,1-ジメチルウレア、1,3-30 ジメチルウレア、1, 1, 3, 3 - テトラメチルウレ ア、1、3-ジフェニルウレア、トリーn-ブチルチオ ウレア等を挙げることができる。前記含窒素複素環化合 物としては、例えば、イミダゾール、4-メチルイミダ ゾール、4-メチル-2-フェニルイミダゾール、ベン ズイミダゾール、2-フェニルベンズイミダゾール等の イミダゾール類;ピリジン、2-メチルピリジン、4-メチルピリジン、2-エチルピリジン、4-エチルピリ ジン、2-フェニルピリジン、4-フェニルピリジン、 2-メチル-4-フェニルビリジン、ニコチン、ニコチ 40 ン酸、ニコチン酸アミド、キノリン、4-ヒドロキシキ ノリン、8-オキシキノリン、アクリジン等のビリジン 類;ピペラジン、1-(2-ヒドロキシエチル)ピペラ ジン等のピペラジン類のほか、ピラジン、ピラゾール、 ピリダジン、キノザリン、プリン、ピロリジン、ピペリ ジン、3-ピペリジノ-1,2-プロパンジオール、モ ルホリン、4-メチルモルホリン、1,4-ジメチルピ ペラジン、1, 4-ジアザビシクロ [2, 2, 2] オク タン等を挙げることができる。

【0117】 これらの含窒素有機化合物のうち、含窒素 50 化合物(イ)、アミド基含有化合物、含窒素複素環化合

物等が好ましい。前記酸拡散制御剤は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。

【0118】また、前記酸解離性基を有する脂環族添加 剤は、ドライエッチング耐性、パターン形状、基板との 接着性等をさらに改善する作用を示す成分である。この ような脂環族添加剤としては、例えば、1-アダマンタ ンカルボン酸 t - ブチル、1 - アダマンタンカルボン酸 t-プトキシカルボニルメチル、1、3-アダマンタン ジカルボン酸ジー t - ブチル、1 - アダマンタン酢酸 t -ブチル、1-アダマンタン酢酸t-ブトキシカルボニ 10 ルメチル、1、3-アダマンタンジ酢酸ジーt-ブチル 等のアダマンタン誘導体類;デオキシコール酸 t - ブチ ル、デオキシコール酸 t - ブトキシカルボニルメチル、 デオキシコール酸2-エトキシエチル、デオキシコール 酸2-シクロヘキシルオキシエチル、デオキシコール酸 3-オキソシクロヘキシル、デオキシコール酸テトラヒ ドロピラニル、デオキシコール酸メバロノラクトンエス テル等のデオキシコール酸エステル類;リトコール酸t - ブチル、リトコール酸 t - ブトキシカルボニルメチ ル、リトコール酸2-エトキシエチル、リトコール酸2 -シクロヘキシルオキシエチル、リトコール酸3-オキ ソシクロヘキシル、リトコール酸テトラヒドロピラニ ル、リトコール酸メバロノラクトンエステル等のリトコ ール酸エステル類等を挙げることができる。これらの脂 環族添加剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す るととができる。

【0119】また、前記界面活性剤は、塗布性、ストリ エーション、現像性等を改良する作用を示す成分であ る。このような界面活性剤としては、例えば、ポリオキ シエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステ 30 アリルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテ ル、ポリオキシエチレンn-オクチルフェニルエーテ ル、ポリオキシエチレンn-ノニルフェニルエーテル、 ポリエチレングリコールジラウレート、ポリエチレング リコールジステアレート等のノニオン系界面活性剤のほ か、以下商品名で、КР341 (信越化学工業 (株) 製)、ポリフローNo. 75, 同No. 95 (共栄社化 学(株)製)、エフトップEF301,同EF303, 同EF352(トーケムプロダクツ(株)製)、メガフ ァックスF171, 同F173 (大日本インキ化学工業 40 (株) 製)、フロラードFC430、同FC431(住 友スリーエム(株)製)、アサヒガードAG710.サ ーフロンS-382, 同SC-101, 同SC-10 2, 同SC-103, 同SC-104, 同SC-10 5, 同SC-106 (旭硝子 (株) 製) 等を挙げること ができる。これらの界面活性剤は、単独でまたは2種以 上を混合して使用することができる。

【0120】また、前記増感剤は、放射線のエネルギーを吸収して、そのエネルギーを酸発生剤(B)に伝達し、それにより酸の生成量を増加する作用を示すもの

で、感放射線性樹脂組成物のみかけの感度を向上させる
効果を有する。このような増感剤としては、アセトフェ
ノン類、ベンゾフェノン類、ナフタレン類、ビアセチ
ル、エオシン、ローズベンガル、ビレン類、アントラセ
ン類、フェノチアジン類等を挙げることができる。これ
ちの増感剤は、単独でまたは2種以上を混合して使用す
ることができる。また、染料あるいは顔料を配合すること
とにより、露光部の潜像を可視化させて、露光時のハレーションの影響を緩和でき、接着助剤を配合することに
より、基板との接着性を改善することができる。さら
に、前記以外の添加剤としては、後述するアルカリ可溶
性樹脂、酸解離性の保護基を有する低分子のアルカリ溶
解性制御剤、ハレーション防止剤、保存安定化剤、消泡
剤等を挙げることができる。

【0121】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、普通、その使用に際 して、全固形分濃度が、通常、5~50重量%、好まし くは10~25重量%となるように、溶剤に溶解したの ち、例えば孔径0.2μm程度のフィルターでろ過する ことによって、組成物溶液として調製される。前記組成 物溶液の調製に使用される溶剤としては、例えば、2-ブタノン、2-ペンタノン、3-メチル-2-ブタノ ン、2-ヘキサノン、4-メチル-2-ペンタノン、3 -メチル-2-ペンタノン、3,3-ジメチル-2-ブ タノン、2-ヘプタノン、2-オクタノン等の直鎖状も しくは分岐状のケトン類;シクロペンタノン、3-メチ ルシクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-メチルシ クロヘキサノン、2,6-ジメチルシクロヘキサノン、 イソホロン等の環状のケトン類;プロピレングリコール モノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコール モノーn-プロピルエーテルアセテート、プロピレング リコールモノーi-プロピルエーテルアセテート、プロ ピレングリコールモノ-n-ブチルエーテルアセテー ト、プロピレングリコールモノ-i-ブチルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノーsec-ブチル エーテルアセテート、プロピレングリコールモノー t-ブチルエーテルアセテート等のプロビレングリコールモ ノアルキルエーテルアセテート類;2-ヒドロキシプロ ピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオン酸エチル、 2-ヒドロキシプロピオン酸n-プロピル、2-ヒドロ キシプロピオン酸 i - プロピル、2 - ヒドロキシプロピ オン酸n-ブチル、2-ヒドロキシプロピオン酸 i-ブ チル、2-ヒドロキシプロピオン酸sec-ブチル、2 -ヒドロキシプロピオン酸 t - ブチル等の2 -ヒドロキ シブロピオン酸アルキル類;3-メトキシブロピオン酸 メチル、3-メトキシプロピオン酸エチル、3-エトキ シプロピオン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチ ル等の3-アルコキシプロピオン酸アルキル類のほか、 50 【0122】n-プロピルアルコール、i-プロピルア

37 ルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチルアルコー ル、シクロヘキサノール、エチレングリコールモノメチ ルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、 エチレングリコールモノーn-プロピルエーテル、エチ レングリコールモノー n - ブチルエーテル、ジエチレン グリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジ エチルエーテル、ジエチレングリコールジーnープロピ ルエーテル、ジエチレングリコールジ-n-ブチルエー テル、エチレングリコールモノメチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテー ト、エチレングリコールモノ-n-プロピルエーテルア セテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレン グリコールモノーn - プロピルエーテル、トルエン、キ シレン、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸エチ ル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、2-ヒドロキシー3ーメチル酪酸メチル、3ーメトキシブチ ルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルアセテ ート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネー ト、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢酸 20 エチル、酢酸n-プロピル、酢酸n-ブチル、アセト酢 酸メチル、アセト酢酸エチル、ピルビン酸メチル、ピル ピン酸エチル、N-メチルピロリドン、N, N-ジメチ ルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ベン ジルエチルエーテル、ジ-n-ヘキシルエーテル、ジエ チレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリ

【0123】これらの溶剤は、単独でまたは2種以上を 混合して使用することができるが、就中、直鎖状もしく は分岐状のケトン類、環状のケトン類、プロピレングリ コールモノアルキルエーテルアセテート類、2-ヒドロ キシプロピオン酸アルキル類、3-アルコキシプロピオ ン酸アルキル類、γ-ブチロラクトン等が好ましい。

コールモノエチルエーテル、カプロン酸、カプリル酸、

1-オクタノール、1-ノナノール、ベンジルアルコー

ル、マレイン酸ジエチル、ケーブチロラクトン、炭酸エ 30

ル、酢酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチ

チレン、炭酸プロピレン等を挙げることができる。

【0124】レジストパターンの形成方法

本発明の感放射線性樹脂組成物は、特に化学増幅型レジ ストとして有用である。前記化学増幅型レジストにおい ては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用 によって、樹脂(A)中の酸解離性基が解離してカルボ キシル基を生じ、その結果、レジストの露光部のアルカ リ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部がアルカ リ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジストパ ターンが得られる。本発明の感放射線性樹脂組成物から レジストパターンを形成する際には、組成物溶液を、回 転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布手段によ って、例えば、シリコンウエハー、アルミニウムで被覆 されたウエハー等の基板上に塗布することにより、レジ 50 ン、3-メチルシクロペンタノン、2,6-ジメチルシ

スト被膜を形成し、場合により予め加熱処理(以下、 「PB」という。)を行ったのち、所定のレジストバタ ーンを形成するように該レジスト被膜に露光する。その 際に使用される放射線としては、使用される酸発生剤 (B)の種類に応じて、可視光線、紫外線、遠紫外線、 X線、荷電粒子線等を適宜選定して使用されるが、Kr Fエキシマレーザー(波長248nm)、ArFエキシ マレーザー(波長193nm)あるいはF,エキシマレ ーザー (波長157nm) に代表される遠紫外線が好ま しい。本発明においては、露光後に加熱処理(以下、 「PEB」という。)を行うことが好ましい。このPE Bにより、酸解離性基の解離反応が円滑に進行する。 P EBの加熱条件は、感放射線性樹脂組成物の配合組成に よって変わるが、通常、30~200℃、好ましくは5 0~170 ℃である。本発明における樹脂(A)、およ び樹脂 (A1) と樹脂 (A2) との混合物は、PEBの 温度が比較的低い場合でも酸解離性基の解離反応が容易 に進行する特性を有するものであり、その意味で、この ような樹脂を用いることにより、工業的有利にレジスト

パターンを形成することができる。 【0125】本発明においては、感放射線性樹脂組成物 の潜在能力を最大限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報等に開示されているように、使用され る基板上に有機系あるいは無機系の反射防止膜を形成し ておくこともでき、また環境雰囲気中に含まれる塩基性 不純物等の影響を防止するため、例えば特開平5-18 8598号公報等に開示されているように、レジスト被 膜上に保護膜を設けることもでき、あるいはこれらの技 術を併用することもできる。次いで、露光されたレジス ト被膜をアルカリ現像液を用いて現像することにより、 所定のレジストパターンを形成する。前記アルカリ現像 液としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウ ム、炭酸ナトリウム、けい酸ナトリウム、メタけい酸ナ トリウム、アンモニア水、エチルアミン、n-プロピル アミン、ジエチルアミン、ジーnープロピルアミン、ト リエチルアミン、メチルジエチルアミン、エチルジメチ ルアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド、ピロール、ピペリジン、コリン、 1,8-ジアザビシクロ-[5,4,0]-7-ウンデ セン、1,5-ジアザビシクロ-[4.3.0]-5-ノネン等のアルカリ性化合物の少なくとも 1 種を溶解し たアルカリ性水溶液が好ましい。前記アルカリ性水溶液 の濃度は、通常、10重量%以下である。この場合、ア ルカリ性水溶液の濃度が10重量%を超えると、非露光 部も現像液に溶解するおそれがあり好ましくない。

【0126】また、前記アルカリ性水溶液には、例えば 有機溶媒を添加することもできる。前記有機溶媒として は、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルi ブチルケトン、シクロペンタノン、シクロヘキサノ

クロヘキサノン等のケトン類:メチルアルコール、エチ ルアルコール、n - プロビルアルコール、i - プロピル アルコール、nープチルアルコール、tープチルアルコ ール、シクロペンタノール、シクロヘキサノール、1, 4-ヘキサンジオール、1,4-ヘキサンジメチロール 等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等 のエーテル類; 酢酸エチル、酢酸n-ブチル、酢酸i--アミル等のエステル類;トルエン、キシレン等の芳香族 炭化水素類や、フェノール、アセトニルアセトン、ジメ チルホルムアミド等を挙げることができる。これらの有 10 機溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用すると とができる。有機溶媒の使用量は、アルカリ性水溶液に 対して、100容量%以下が好ましい。この場合、有機 溶媒の使用量が100容量%を超えると、現像性が低下 して、露光部の現像残りが多くなるおそれがある。ま た、前記アルカリ性水溶液には、界面活性剤等を適量添 加することもできる。なお、アルカリ現像液で現像した のちは、一般に、水で洗浄して乾燥する。

39

[0127]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 20 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。こ とで、部は、特記しない限り重量基準である。実施例お よび比較例における各測定・評価は、下記の要領で行っ

Mw: 東ソー(株) 製GPCカラム(G2000HXL2 本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本) を用 い、流量1.0ミリリットル/分、溶出溶媒テトラヒド ロフラン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリ スチレンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグ 30 ラフィー (GPC) により測定した。

放射線透過率:組成物溶液を石英ガラス上にスピンコー トにより塗布し、90℃に保持したホットプレート上で 60秒間PBを行って形成した膜厚0.34 µmのレジ スト被膜について、波長193nmにおける吸光度か ら、放射線透過率を算出して、遠紫外線領域における透 明性の尺度とした。

【0128】感度:基板として、表面に膜厚820人の ARC25 (ブルワー・サイエンス (Brewer Science) 社製)膜を形成したシリコーンウェハー(ARC25) を用い、各組成物溶液を、基板上にスピンコートにより 塗布し、ホットプレート上にて、表2に示す条件でPB を行って形成した膜厚0.34μmのレジスト被膜に、 (株) ニコン製A r F エキシマレーザー露光装置 (レン ズ開口数0.55、露光波長193nm)により、マス クパターンを介して露光した。その後、表2に示す条件 でPEBを行ったのち、2.38重量%のテトラメチル アンモニウムヒドロキシド水溶液により、25℃で60 秒間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型のレジストパタ ーンを形成した。このとき、線幅0.16μmのライン 50

・アンド・スペースパターン(1L1S)を1対1の線 幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露光量 を感度とした。

解像度:最適露光量で解像される最小のレジストパター ンの寸法を、解像度とした。

【0129】ドライエッチング耐性:組成物溶液をシリ コーンウエハー上にスピンコートにより塗布し、乾燥し て形成した膜厚0.5μmのレジスト被膜に対して、P MT社製ドライエッチング装置 (Pinnacle8000) を用 い、エッチングガスをCF、とし、ガス流量75scc m、圧力2.5mTorr、出力2,500Wの条件で ドライエッチングを行って、エッチング速度を測定し、 クレゾールノボラック樹脂からなる被膜のエッチング速 度に対する相対値により、相対エッチング速度を評価し た。エッチング速度が小さいほど、ドライエッチング耐 性に優れることを意味する。

パターン形状:線幅0.16μmのライン・アンド・ス ペースパターン(1L1S)の方形状断面の下辺寸法し b と上辺寸法La とを走査型電子顕微鏡により測定し、 0.85≦La/Lb≦1を満足し、かつパターン形状 が裾を引いていない場合を、パターン形状が"良好"と した。

【0130】合成例1

下記式(7)で表される化合物(以下、「メタクリル酸 エステル (7)」という。) 51.02g (50モル %)、下記式(8)で表される化合物(以下、「メタク リル酸エステル(8)」という。) 27. 29g(30 モル%)、下記式(9)で表される化合物(以下、「メ タクリル酸エステル(9)」という。)21.69q (20モル%) およびアゾビスイソ吉草酸メチル4.2 2gを2-ブタノン100gに溶解した単量体溶液を準 備した。別に、容量1,000ミリリットルの三口フラ スコに2-ブタノン200ミリリットルを入れて、30 分間窒素パージを行ったのち、攪拌しながら80℃に保 持し、前記単量体溶液を滴下漏斗から3時間かけて滴下 し、さらに3時間加熱して重合した。重合終了後、反応 溶液を水冷して30℃以下に冷却し、メタノール2,0 00g中へ投入して、析出した白色粉末をろ別した。そ の後、白色粉末をメタノール400gと混合する洗浄操 作を2回行って、炉別したのち、50℃にて17時間乾 燥して、白色粉末の樹脂69g(収率69重量%)を得 た。この樹脂はMwが9、200であり、メタクリル酸 エステル (7)、メタクリル酸エステル (8) およびメ タクリル酸エステル (9) に由来する各繰り返し単位の 含有率が50.2/29.2/20.6(モル%)の共 重合体であった。この樹脂を樹脂(A-1)とする。

[0131]

【化18】

【0132】合成例2

下記式(10)で表される化合物(以下、「メタクリル 酸エステル(10)」という。) 53.78g(50モ ル%)、メタクリル酸エステル(8)25.75g(3 0モル%)、メタクリル酸エステル(9)20.47g (20モル%) およびアゾビスイソ吉草酸メチル3.9 9gを2-ブタノン100gに溶解した単量体溶液を用 いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂6 7g(収率67重量%)を得た。この樹脂はMwが9. 700であり、メタクリル酸エステル(10)、メタク 20 が8,900であり、メタクリル酸エステル(7)、メ リル酸エステル(8)およびメタクリル酸エステル (9) に由来する各繰り返し単位の含有率が48.4/ 30.2/21.4 (モル%) の共重合体であった。と の樹脂を樹脂(A-2)とする。

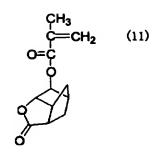
[0133] 【化19】

$$\begin{array}{c}
\mathsf{CH}_{3} \\
\mathsf{C} = \mathsf{CH}_{2} \\
\mathsf{O} = \mathsf{C} \\
\mathsf{O} \\
\mathsf{C}_{2}\mathsf{H}_{5}
\end{array}$$

【0134】合成例3

メタクリル酸エステル (7)50.19g (50モル %)、メタクリル酸エステル(8)18.00g(20 モル%)、メタクリル酸エステル(9)21.34g (20モル%)、下記式(11)で表される化合物(以 下、「メタクリル酸エステル(11)」という。)1 0.09g(10モル%) およびアゾビスイソ吉草酸メ チル4. 18gを2-ブタノン100gに溶解した単量 体溶液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉 末の樹脂72g(収率72重量%)を得た。この樹脂は Mwが9, 400であり、メタクリル酸エステル (7)、メタクリル酸エステル(8)、メタクリル酸エ ステル(9) およびメタクリル酸エステル(11) に由 来する各繰り返し単位の含有率が49.4/20.6/ 20.2/9.8 (モル%) の共重合体であった。この 樹脂を樹脂(A-3)とする。

【化20】



【0136】合成例4

メタクリル酸エステル(7)29.90g(30モル %)、メタクリル酸エステル(8)26.65g(30 モル%)、メタクリル酸エステル(9)21.18g (20モル%)、メタクリル酸エステル(10)22. 26g(20モル%) およびアゾビスイソ吉草酸メチル 4. 13gを2-ブタノン100gに溶解した単量体溶 液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の 樹脂67g(収率67重量%)を得た。この樹脂はMw タクリル酸エステル(8)、メタクリル酸エステル (9) およびメタクリル酸エステル(10) に由来する 各繰り返し単位の含有率が31.2/30.1/19. 8/18.9 (モル%) の共重合体であった。この樹脂 を樹脂(A-4)とする。

【0137】合成例5

下記式(12)で表されるメタクリル酸エステル(以 下、「メタクリル酸エステル(12)」という。)3 5. 59g(40モル%)、下記式(13)で表される 30 メタクリル酸エステル(以下、「メタクリル酸エステル (13)」という。) 15, 55g(15モル%)、メ タクリル酸エステル(11)48.86g(45モル %) およびアゾビスイン酪酸メチル6.75gを2-ブ タノン100gに溶解した単量体溶液を用いた以外は、 合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂76g(収率7 6重量%) を得た。この樹脂はMwが7,300であ り、メタクリル酸エステル(12)、メタクリル酸エス テル(13) およびメタクリル酸エステル(11) に由 来する各繰り返し単位の含有率が37.5/14.8/ 47.7 (モル%)の共重合体であった。この樹脂を樹 脂(A-5)とする。

[0138] 【化21】

[0135]

【0139】合成例6

下記式(14)で表されるメタクリル酸エステル(以下、「メタクリル酸エステル(14)」という。)37.73g(35モル%)、メタクリル酸エステル(12)11.61g(15モル%)、メタクリル酸エステル(13)9.76g(10モル%)、メタクリル酸エステル(13)40.90g(40モル%)およびアゾビスイソ酪酸メチル5.29gを2ーブタノン100gに溶解した単量体溶液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂73g(収率73重量%)を得た。この樹脂はMwが7,800であり、メタクリル酸エステル(14)、メタクリル酸エステル(12)、メタクリル酸エステル(13)およびメタクリル酸エステル(13)およびメタクリル酸エステル(11)に由来する各繰り返し単位の含有率が33.3/13.2/9.3/44.2(モル%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-6)とする。

[0140] [化22]

【0141】合成例7

メタクリル酸エステル (7) 16.48g (15モル%)、メタクリル酸エステル (12) 29.10g (35モル%)、メタクリル酸エステル (13) 10.49g (10モル%)、メタクリル酸エステル (11) 43.93g (40モル%) およびアゾビスイソ酪酸メチル5.69gを2-ブタノン100gに溶解した単量体溶液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂69g (収率69重量%)を得た。この樹脂はMwが7,500であり、メタクリル酸エステル (7)、メタクリル酸エステル (12)、メタクリル酸エステル (13) およびメタクリル酸エステル (11) に由来する各繰り返し単位の含有率が13.8/33.7/8.7/43.8 (モル%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂 (A-7) とする。

【0142】合成例8

メタクリル酸エステル(7)40.73g(40モル%)、下記式(15)で表されるメタクリル酸エステル(以下、「メタクリル酸エステル(15)」という。)13.47g(15モル%)、メタクリル酸エステル(11)45.80g(45モル%)およびアゾビスイソ酪酸メチル5.27gを2ーブタノン100gに溶解した単量体溶液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂77g(収率77重量%)を得た。10 この樹脂はMwが8,100であり、メタクリル酸エステル(7)、メタクリル酸エステル(15)およびメタクリル酸エステル(11)に由来する各繰り返し単位の含有率が37.5/14.1/48.4(モル%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-8)とする。【0143】

【化23】

$$\begin{array}{c}
\mathsf{CH}_{3} \\
\mathsf{C} = \mathsf{CH}_{2} \\
\mathsf{O} = \mathsf{C} \\
\mathsf{O} \\
\mathsf{C}_{2}\mathsf{H}_{5}
\end{array}$$

【0144】合成例9

メタクリル酸エステル(14)34.31g(35モル %)、下記式(16)で表されるメタクリル酸エステル (以下、「メタクリル酸エステル(16)」という。) 10.55g(15モル%)、下記式(17)で表され るメタクリル酸エステル(以下、「メタクリル酸エステ 30 ル (17)」という。) 22. 61g (15モル%)、 メタクリル酸エステル(11)32.54g(35モル %) およびアゾビスイソ酪酸メチル4.81gを2-ブ タノン100gに溶解した単量体溶液を用いた以外は、 合成例1と同様にして、白色粉末の樹脂86g(収率8 6重量%) を得た。この樹脂はMwが12,700であ り、メタクリル酸エステル(14)、メタクリル酸エス テル(16)、メタクリル酸エステル(17) およびメ タクリル酸エステル(11)に由来する各繰り返し単位 の含有率が32.9/13.8/12.4/40.9 (モル%)の共重合体であった。この樹脂を樹脂(A-9) とする。

【0145】 【化24】

【0146】合成例10

メタクリル酸エステル (7) 14.26g (15モル %)、メタクリル酸エステル(15)29.36g(3 5モル%)、メタクリル酸エステル(17)23.11 g(15モル%)、メタクリル酸エステル(11)3 3. 27g (35モル%) およびアゾビスイソ酪酸メチ ル4. 92gを2-ブタノン100gに溶解した単量体 溶液を用いた以外は、合成例1と同様にして、白色粉末 の樹脂72g(収率72重量%)を得た。この樹脂はM 20 ズイミダゾール wが13,100であり、メタクリル酸エステル (7)、メタクリル酸エステル(15)、メタクリル酸 エステル(17) およびメタクリル酸エステル(11) に由来する各繰り返し単位の含有率が14.3/32. 9/12.8/40.0 (モル%) の共重合体であっ た。この樹脂を樹脂 (A-10)とする。

[0147]

【実施例】実施例1~11および比較例1

表1に示す成分からなる各組成物溶液について、各種評 価を行った。評価結果を表3に示す。表1における樹脂 (A-1)~(A-10)以外の成分は以下のとおりである。 他の重合体

a-1: メタクリル酸 t - ブチル/メタクリル酸メチル/ メタクリル酸共重合体(共重合モル比=40/40/2 0, Mw = 20, 000)

酸発生剤(B)

10 テトラヒドロチオフェニウムノナフルオローnーブタン スルホネート

B-2:1-(3,5-i)ル) テトラヒドロチオフェニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート

B-3: トリフェニルスルホニウムノナフルオロ-n-ブ タンスルホネート

酸拡散制御剤

C-1:2-フェニルベンズイミダゾール

C-2: N-t-ブトキシカルボニル-2-フェニルベン

溶剤

D-1: プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテ

D-2:2-ヘプタノン

D-3: シクロヘキサノン

[0148]

【表1】

_ 表					
	樹間	酸発生剤 (B) (部)	酸域物制 (部)	溶剤(部)	
実施例1	A-1 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-1 (600)	
実施例 2	A-1 (60) A-2 (40)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-2 (600)	
実施例3	A-1 (60) A-2 (40)	B-2 (5)	C-1 (0. 25)	D-2 (600)	
実施例4	A-3 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-2 (450) D-3 (200)	
実施例 5	A-4 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-1 (600)	
実施例6	A-5 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-1 (420) D-3 (180)	
実施例7	A-6 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-1 (420) D-3 (180)	
実施例8	A-7 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.25)	D-1 (420) D-3 (180)	
実施例9	A-8 (100)	B-1 (5)	C-1 (0.60)	D-1 (420) D-3 (180)	
実施例10	A-9 (100)	B-1 (5)	C-1 (1.10)	D-1 (420) D-3 (180)	
実施例11	A-10 (100)	B-1 (5)	C-1 (1.10)	D-1 (420) D-3 (180)	
比較例1	a-1 (100)	B-3 (3)	C-2 (0.90)	D-2 (600)	

[0149]

f_ ,

* *【表2】

	レジスト被膜	基板の種類	РВ		PEB	
	の順写 (μm)		温度 (°C)	時間(秒)	温度 (C)	時間(秒)
実施例1	0.34	ARC25	120	90	90	90
実施例2	0.34	ARC25	120	90	110	90
実施例3	0.34	ARC25	120	90	110	90
実施列4	0.34	ARC25	120	90	90	90
実施例 5	0.34	ARC25	120	90	110	90
実施例6	0.34	ARC25	110	90	110	90
実施例7	0.34	ARC25	110	90 .	120	90
実施例8	0.34	ARC25	110	90	90	90
実施列9	0.34	ARC25	110	90	105	90
実施例10	0.34	ARC25	120	90	130	90
実施例1	0.34	ARC25	110	90	105	90
比較例1	0.34	ARC25	130	90	130	90

[0150]

【表3】



_ <u>表_3_</u>					
	放身據透過率 (193mm,%)	感 度 (J m2)	解傳度 (µm)	ドライエッチング 新性	バターン形状
実施例1	6.8	216	0.13	0.8	良好
実施例2	7 1	2 1 3	0.13	0.7	良好
実施例3	7 3	227	0. 13	0.7	良好
実施例4	6 7	203	0.13	0.8	良好
実施例 5	7 0	2 1 5	0.13	0.7	良好
実施列 6	7 1	210	0.13	0.7	良好
実施例7	7 2	2 1 9	0.13	0.8	段好
実施例8	70	2 2 5	0.13	0. 7	良好
実施例9	70	206	0.13	0. 7	良好
実施列10	73	185	0.13	0. 7	良好
実施列11	7 4	174	0.13	0. 7	良好
比較1	6 7	192	0.16	1.0	良好

[0151]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、活性 m) あるいはArFエキシマレーザー(波長193n m) に代表される遠紫外線に感応する化学増幅型レジス トとして、放射線に対する透明性が高く、特に解像度に米

49

*優れており、しかも感度、ドライエッチング耐性、パタ ーン形状にも優れ、また基板に対する接着性およびパタ 光線、例えばKrFエキシマレーザー(波長248n 20 ーンの裾形状も良好であり、今後ますます微細化が進行 すると予想される集積回路素子の製造に極めて好適に使 用できる。

フロントページの続き

(72)発明者 山本 將史

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 西村 功

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA03 AA09 AB16

AC04 AC08 AD03 BE00 BE10

BG00 CB14 CB41 FA17

4J100 AL08P AL08Q AL08R BA03R

BB18R BC03P BC08P BC08R

BC09P BC09R BC53Q CA04

CA05 CA06 FA02 JA37